

YJ7N60C为N沟道增强型高压MOS管

产品名称	YJ7N60C为N沟道增强型高压MOS管
公司名称	深圳市扬晶微电子有限公司
价格	.98/PCS
规格参数	品牌:扬晶 型号:YJ7N60C 电流7A:耐压600V
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道和平路368号龙胜商业大厦4层K区
联系电话	0755-28108558 18948333261

产品详情

深圳市扬晶微电子有限公司,是一家专业制造半导体分立器件及ic的高科技企业。是中国主要专业从事半导体分立器件及ic研发、生产、销售及技术支持制造商。

生产品种有：二、三极管系列，高、低压mos系列，电源管理ic (ac-dc/dc-dc)，线性稳压ic，低压差线性稳压ic，ldo，三端稳压ic，基准源ic，led驱动ic，降压、升压ic，电压检测，运算放大器，电压比较器，时基电路，功放电路，可控硅，整流桥等等。

描述

yj7n60c为n沟道增强型高压功率mos场效应管。该产品可广泛适用于ac-dc开关电源，dc-dc电源转换器，高压h桥pmw马达驱动。特点 7a,600v,rds(on)(典型值) 0.8

低电荷、低反向传输电容 开关速度快

极限值 (tc=25)

参数名称 符号 数值 单位 漏极—源极电压 v_{dss} 600 v 漏极电流 tc=25 id 7 a 栅源电压 v_{gs} ± 30 v 耗散功率 tc=25 pd 48 w 结温 tj 150

特性参数值 (tc=25)

参数说明	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源反向电压	bv_{dss}	$v_{gs}=0V, i_d=250\mu A$	600	—	—	V
漏源截止电流	i_{dss}	$v_{ds}=600V, v_{gs}=0V$	—	1	—	μA
栅源截止电流	i_{gss}	$v_{ds}=0V, v_{gs}=\pm 30V$	—	—	± 100	nA
通态电阻	$r_{ds(on)}$	$v_{gs}=10V, i_d=3.5A$	—	0.81	2	Ω
栅-源极开启电压	$v_{gs(th)}$	$v_{ds}=v_{gs}, i_d=250\mu A$	2.0	—	4.0	V
源漏二极管正向导通电压	v_{fsd}	$i_s=7A, v_{gs}=0V$	—	—	1.4	V
储存温度	t_{stg}	—	-55	—	150	°C